經濟部所屬事業機構 110 年新進職員甄試試題

類科組:電機(一)、電機(二)、儀電

目:1.電路學2.電子學

(D) 1. 若一台吹風機的額定操作功率為 1200 瓦特,試問將其連續操作 50 分鐘後,將消耗多 少度電能?

(A)10 度

(B)5 度

(C)1.2 度

(D)1 度

某一電器之輸入電壓及輸入電流分別為110 V及10 A,而輸出電壓及輸出電流分別為 (B) 100 V 及 8.8 A, 則此電器效率為下列何者?

(A)70 %

(B)80 %

(C)90 %

(D)95%

將 110 V/400 W 的電燈泡接上電源,使用 6 小時後,如電費每度1元,總共將支出多少 (A) 3. 電費?

(A)2.4 元

(B)2.64 元

(C)4.4 元

(D)6.6 元

(D) 4. 下列對於導線電阻值的敘述,何者正確?

(A)電阻與截面積無關

(B)電阻與截面積成正比

(C)電阻與長度無關

(D)電阻與長度成正比

(B) 兩電阻 R₁、R₂ 並聯, 其等效電阻為下列何者?

 $(A)(R_1 + R_2) / R_1 R_2$

(B) $R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$

 $(C)R_1 + R_2$

 $(D)R_1R_2$

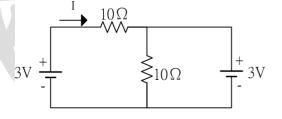
某電路如右圖所示,電流 [為多少安培? (D)

(A)1A

(B)0.5 A

(C)0.1A

(D)0A



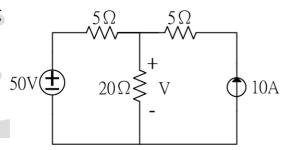
(D) 試求右圖所示的直流電路中,跨於20歐姆的電 7. 阻器雨端之電壓為多少?

(A)150 V

(B)100 V

(C)90 V

(D)80 V



(C) 有關理想電壓源的敘述,下列何者正確? 8.

(A)電流恆定

(B)輸出為電感型 (C)內阻為零

如右圖所示電路,其中的電流 I 為何? (A) 9.

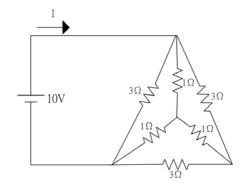
(A)10A

(B)5A

(C)2A

(D)1A

(D)輸出為電容性



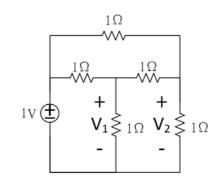
(C) 10. 如右圖所示,電路中的 $V_1 \, V_2$ 電壓為何?

$$(A)V_1 = 4.5 \text{ V} \cdot V_2 = 0.5 \text{ V}$$

(B)
$$V_1 = 1.5 \text{ V} \cdot V_2 = 3.5 \text{ V}$$

$$(C)V_1 = 0.5 \text{ V} \cdot V_2 = 0.5 \text{ V}$$

(D)
$$V_1 = 3.5 \text{ V} \cdot V_2 = 1.5 \text{ V}$$

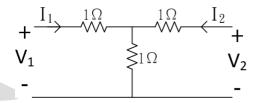


(C) 11. 試求右圖中雙埠網路的 Y 參數, Y_{12} 和 Y_{22} 之值為

何?

- (A) $1/3 \cdot 2/3$
- (A) 1/3 · 2/3
- (C) $-1/3 \cdot 2/3$

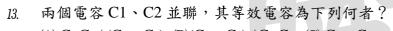
- (B) $1/3 \cdot -2/3$
- (D) $-1/3 \cdot -2/3$



(D) 12. 試求右圖中雙埠網路的 Z 參數, Z₁₂和 Z₂₂之值為

何?

- (A) $-1/3 \cdot -5/3$
- (B)- $5/3 \cdot 1/3$
- (C) $5/3 \cdot -1/3$
- (D) $1/3 \cdot 5/3$



- (A) $C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$ (B) $(C_1 + C_2) / C_1 C_2$ (C) $C_1 + C_2$
- 下列何種元件的儲存能量與電壓平方成正比?
- (A)電感

(C)

(B)

14.

- (B)電容
- (C)電阻
- (D)二極體

(D) $C_1 C_2$

 1Ω

(A) 15. A 電容器為 40 微法拉,耐壓 500 伏特; B 電容器為 60 微法拉,耐壓 100 伏特; C 電容器為120 微法拉,耐壓 200 伏特,將以上三個電容器串聯後耐壓為多少伏特?

- (A)300
- (B)400
- (C)500
- (D)600

(A) 16. 一個 10 微法拉電容器以 30 微安培之定電流源充電,若電容器充電前電壓為零,則充電 20 秒後電容器上的電壓為多少伏特?

- (A)60
- (B)30
- (C)20
- (D)10

(B) 17. 一個 200 微法拉電容器已充電至 $100 \, \text{V}$,且電容器開闢切開之瞬間電壓 $V(0^-) = 100 \, \text{V}$,請問電容器儲存能量與 $V(0^+)$ 為何?

- $(A)0.1 J \cdot 200 V$
- (B)1 J · 100 V
- $(C)10 J \cdot 200 V$
- (D) $10 J \cdot 100 V$

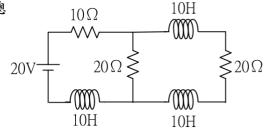
(B) 18. 若右圖中之電感電路已達穩態,試求全部電感之總儲存電能為何?

(A)9.5 J

(B)7.5 J

(C)5.5 J

(D) 3.5 J



(C) 19. 一個元件的電壓及電流分別為 $10\cos(3t + 30^\circ)$ 伏特與 $-2\sin(3t + 60^\circ)$ 安培,其相位關係相差多少度?

- $(A)100^{\circ}$
- $(B)110^{\circ}$
- $(C)120^{\circ}$
- $(D)130^{\circ}$

(A) 20. 已知 f(t) 的拉普拉斯轉換為 $F(S) = \frac{s^3 + s + 3}{s^3 + 2s^2 + s + 2}$,請問 f(t)為下列何者?

- (A) e^{-2t} + sint
- $(B)e^{-3t} + sint$
- (C) $e^{-2t} + \cos t$
- (D) $e^{-3t} + \cos t$

共6頁 第2頁

全國最大公教職網站

https://www.public.com.tw

(C) 21. 三相負載每相阻抗皆為6+j8歐姆且為Y接線,若每相之相電流為20安培(有效值), 則此三相負載消耗之總平均功率為多少瓦特?

(A)3000 W

(B)4900 W

(C)7200 W

(D)8100 W

(A) 22. 一個平衡的三相電路在其Y型連接之負載側所量得的線電壓均方根 (RMS) 值為 173.2 V,若此三相負載之總消耗實功率為 300 W,且負載的功因為 0.6 滯後,則流入此三相負載的線電流有效值為多少安培?

(A)1.667 A

(B)1.333 A

(C)0.962 A

(D)0A

(C) 23. 有關 RLC 並聯諧振電路,下列敘述何者有誤?

(A)諧振時阻抗最大

(B)諧振時功率因數為1

(C)諧振時電流最大

(D)諧振時呈電阻性

(A) 24. 有關右圖所示之諧振電路,其諧振頻率下列 何者正確?

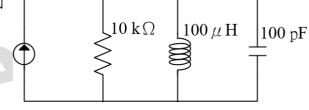
门有工作:

(A)1592 kHz

(B) $2592 \, \text{kHz}$

(C)3592 kHz

(D)4592 kHz



(D) 25. 針對一個阻抗大小為j20 歐姆的負載,若通以一電流源i(t) = 10cos(3t + 30°) 安培時,其所消耗之平均實功率為多少?

(A)2000 W

(B)1000 W

(C)600 W

(D)0W

(D) 26. 若一齊納二極體 (Zener Diode) 在 25 °C 時崩潰電壓為 15 V, 溫度係數為 0.02 %/°C, 若溫度上升至 60 °C, 求崩潰電壓為何?

(A)15.235 V

(B)15.2 V

(C)15.135 V

(D)15.105 V

(A) 27. 下列何者不是二極體常見的功用?

(A) 濾波

(B)保護

(C) 整流

(D)截波

(C) 28. 對一 PN 二極體施加逆向偏壓,有關逆向飽和電流 Is 的敘述何者有誤?

(A)逆向偏壓時會產生極小的逆向飽和電流 Is (約 10⁻¹⁵ A)

(B)Is 由少數載子數量控制

(C)溫度越高, Is 會下降

(D)Junction 面積增加會使 Is 上升

(C) 29. 有關 NPN 接面之 BJT 電晶體,下列敘述何者有誤?

(A)基極-射極、基極-集極接面皆施予順向偏壓,電晶體將工作於飽和區

(B)當基極電流逐漸下降為 0,電晶體將進入截止區

(C)在飽和區工作之電晶體,若持續對基極-集極增加順向偏壓,增益參數 β 會上升

(D)一般 BJT 之電壓增益參數 β 會隨著接面溫度 T; 上升而增加

(A) 30. 如右圖之電路,假設 $I_o=10~\mu A$,BJT $Q_1 \times Q_2 \times Q_3$ 的電流增益 β 均為 100 , $V_T=25~mV$,且厄利電壓 (Early Voltage) $|V_A|=25~V$,求 R_o 的電阻值為多少?

(A)13.51 M Ω

(B)23.51 M Ω

(C)33.51 M Ω

(D)43.51 $M\Omega$

 I_{REF} Q_1 Q_3 Q_2 $R=11.5 \text{ k}\Omega$

(C) 31. 如右圖之 JFET 共源極放大器電路,若 $V_{GS}=15~V$ 時,反向漏電流 $I_{GSS}=60~nA$,由信號源看入之輸入阻抗為何?

 $(A)30 M\Omega$

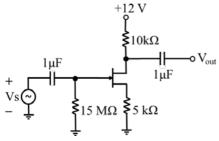
共6頁 第3頁 全國最大公教職網站

https://www.public.com.tw

 $(B)15 M\Omega$

(C)14.15 $M\Omega$

 $(D)3.75 M\Omega$



對一MOSFET以一固定的 V_{GS} 電壓操作於飽和區,在 $V_{DS}=4V$ 時, $i_D=2mA$,且 (B) $V_{DS} = 6 \text{ V}$ 時, $i_D = 2.05 \text{ mA}$,請問其厄利電壓(Early Voltage) $|V_{\triangle}|$ 為多少?

(A)70 V

(B)76 V

(C)80 V

(D)86 V

下列何種邏輯閘具有最短的傳遞延遲時間? (A) 33.

(B)CMOS

(C)TTL

(D)N-MOS

在積體電路中,NMOS 的基體 (B)端應與下列何者相接? (B) 34.

(A)汲極 (Drain)

(B)最低電壓點

(C)源極 (Source)

(D)最高電壓點

FET 場效電晶體相較於BJT 電晶體的特性敘述,下列何者有誤? (B) 35.

(A)FET 是單極性裝置

(B)FET 具有高電流驅動能力

(C)FET 可作為對稱性的雙向開關

(D)FET 較無雜訊產生

對基本放大器增加負回授後,下列特性敘述何者有誤? (D) 36.

(A)雜訊對電路的影響降低

(B)頻寬增加

(C)放大器的增益會衰減

(D)增益與頻寬的乘積提高

由 CMOS FET 組成傳輸閘 (Transmission Gate) 時,組成元件為下列何者? **(C)** 37.

(A)只有 NMOS (B)只有 PMOS (C) NMOS + PMOS (D) JFET

有一差動放大器,其兩輸入電壓分別為 $V_{i1}=50~\mu V$, $V_{i2}=40~\mu V$, 共模拒斥比CMRR= (B) 38. 40 dB, 差模增益 Ad = 250, 則下列何者正確?

(A)差模輸入電壓 $V_d = 5 \mu V$

(B) 共模增益 $A_c = 2.5$

(C) 共模輸入電壓 $V_c = 90 \mu V$

(D)輸出電壓 V_o = 5.25 mV

(C) 39. 如右圖所示電晶體電路,假設輸入信號 V。為交流小信號 且無直流成分,又電晶體的ro可忽略,則右圖之輸入電阻 Rin為何?

 $(A)r_{\pi}+(R_{E}/\!\!/R_{L})$

 $(B)r_e + (R_E // R_L)$

 $(C)r_{\pi}+(1+\beta)(R_{E}//R_{L})$

(D) $r_e + (1 + \beta)(R_E // R_L)$

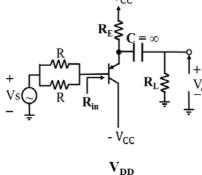
如右圖所示電路,已知FET 參數 $g_m = 1 \text{ mS}$, $r_d = 20 \text{ k}\Omega$, (D) 40. 若此電路具回授(Feedback)的狀態,下列敘述何者有誤?

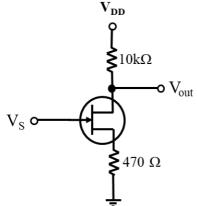
(A)此為串串 (series-series) 回授型態

(B)回授因子 (Feedback factor) β 為 0.47 kΩ

(C)開迴路增益 (Open loop gain) A 為 0.66 mA/V

 $(D)^{\frac{V_{out}}{V}}$ 為 -10





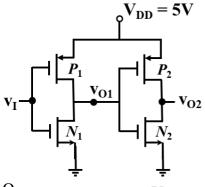
(B) 41. 如右圖電路,已知CMOS 反向電路的 $V_{TN} = 0.8 \text{ V}$, $V_{TP} = -0.8 \text{ V}$ 且 $K_n = K_p$,假設 $v_{o1} = 4 \text{ V}$ 時,請問 v_{I} 的電壓值為多少?

(A)1.55 V

(B)2.40 V

(C)2.86 V

(D)3.75 V



(C) 42. 如右圖達靈頓電路中,假設每個晶體 $\beta=100$, $R_{\it E}=500~\Omega$,

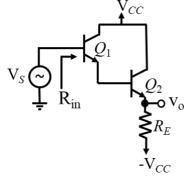
則Rin輸入電阻為何?

 $(A)500 \Omega$

 $(B)3.2 M\Omega$

 $(C)5.1~M\Omega$

(D)8.5 MΩ



(C) 43. 串級(Cascade)電晶體組態中,為求得最大電壓增益,通常使用下列何者放大器組態作為第二級放大器?

(A)共集極

(B)共基極

(C)共射極

(D)共源極

(B) 44. 4級串級放大器,若每一級截止頻率都相同,即 $f_L = 200 \text{ Hz}$, $f_H = 50 \text{ kHz}$,則該 4級串級放大器之頻寬 B 應為何?

(A)11.3 kHz

(B)21.3 kHz

(C)49.7 kHz

(D)50.3 kHz

(A) 45. 某一電晶體電路的 $I_C = 1.5 \text{ mA} \cdot V_T = 0.025 \text{ V} \cdot f_T = 956.4 \text{ MHz}$,其中 $C_\pi = 9 \text{ pF}(EB$ 接面電容),試求 $C_\mu(CB$ 接面電容) 值為多少?

(A)1 pF

(B)3 pF

(C)5 pF

(D)6 pF

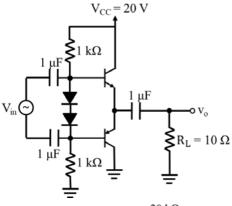
(B) 46. 有一 AB 類放大器電路如右圖,試求其最大的交流 負載功率 $P_{O(max)}$ 為何?

(A)3 W

(B)5 W

(C)12 W

(D)20 W



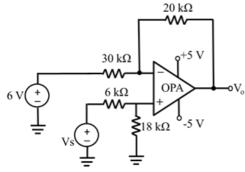
(D) 47. 右圖所示電路是理想的運算放大器,若運算放大器 進入飽和狀態, Vs 可能為下列何者?

(A)0V

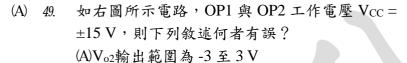
(B)3V

(C)6V

(D)9V



- (A) 48. 運算放大器電路如右圖所示,輸入電阻 R_{in} 為下列何者?
 - (A) -1.5 R
 - (B)-R
 - (C) R
 - (D)1.5 R



- (B)回授因子 (Feedback factor) $\beta = 0.25$
- (C)振盪週期 5 ms
- (D)V₀₂輸出為三角波訊號
- (D) 50. 右圖電路為下列何種電路?
 - (A)TTL 或閘 (OR)
 - (B)TTL 反或閘 (NOR)
 - (C)ECL 或閘 (OR)
 - (D)ECL 反或閘 (NOR)

